

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHẤT BÁN DẪN NANO 10

Tờ Nihon Keizai của Nhật Bản đưa tin công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc và hãng Toshiba của Nhật Bản cùng với hãng Intel của Mỹ và một số hãng khác đã cùng bắt tay vào một dự án nghiên cứu quốc tế để phát triển công nghệ chế tạo chất bán dẫn

Tờ Nihon Keizai của Nhật Bản đưa tin công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc và hãng Toshiba của Nhật Bản cùng với hãng Intel của Mỹ và một số hãng khác đã cùng bắt tay vào một dự án nghiên cứu quốc tế để phát triển công nghệ chế tạo chất bán dẫn thế hệ mới.

Dự án này sẽ kéo dài đến năm 2016 và được tiến hành ở Trung tâm phát triển nghiên cứu của Nhật Bản đặt tại thành phố Tsukuba thuộc tỉnh Ibaraki.

Bộ nhớ SmartNAND 24-nm.

Mục tiêu của nghiên cứu chung lần này là tìm cách thu hẹp khoảng 10nm, tương đương với giảm trên một nửa độ lớn của đường dây mạch điện bán dẫn tốt nhất hiện nay nhưng sẽ mở rộng về dung lượng bộ nhớ bán dẫn.

Dự báo, nếu công nghệ mang tên nano 10 này được phát triển thành công thì dung lượng bộ nhớ bán dẫn có thể được tăng lên gấp ba lần so với bộ nhớ hiện tại, tức là có thể chứa được 100 tập phim, nhưng kích cỡ của nó sẽ giảm xuống chỉ còn tương đương một con tem nhỏ.

Hãng Samsung và Toshiba cũng cho rằng công nghệ nano 10 có thể được ứng dụng trong bộ nhớ flash NAND để ứng dụng trong các sản phẩm công nghệ thông tin như điện thoại di động.